



ダイオードブリッジ部(6素子) Part of Diode Bridge(6 Arm.)

■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	*1 IRM	Tj = 125°C, V <sub>RM</sub> = V <sub>RRM</sub>	15	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	*1 V <sub>FM</sub>	Tj = 25°C, I <sub>FM</sub> = 150A	1.28	V
熱抵抗 Thermal Resistance	R <sub>th(j-c)</sub>	接合部-ケース間(トータル) Junction to Case, Total	0.08	°CW

\*1 : 1アーム当たりの値 Value Per 1 Arm.

サイリスタ部(1素子) Part of Thyristor(1 Arm.)

■最大定格 Maximum Rating

項目 Parameter	記号 Symbol	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off State Voltage	*2 V <sub>DRM</sub>	800	V
非くり返しピークオフ電圧 Non-Repetitive Peak Off State Voltage	*2 V <sub>DSM</sub>	900	V

\*2 : 逆電圧を印加しないこと Can not be Biased for Thyristor

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
サージオン電流 Surge On-State Current	I <sub>1SM</sub>	50Hz 正弦半波, 1サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	3200	A
電流二乗時間積 I Squared t	I <sup>2</sup> t	2~10ms	51200	A <sup>2</sup> s
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current	di/dt	V <sub>D</sub> = 2/3 V <sub>DRM</sub> , I <sub>TM</sub> = 2 · I <sub>o</sub> , Tj = 125°C I <sub>G</sub> = 300mA, di <sub>G</sub> /dt = 0.2A/μs	100	A/μs
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power	P <sub>GM</sub>		5	W
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	P <sub>G(AV)</sub>		1	W
ピークゲート電流 Peak Gate Current	I <sub>GM</sub>		2	A
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage	V <sub>GM</sub>		10	V
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	V <sub>RGM</sub>		5	V

■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min	標準 Typ	最大 Max	
ピークオフ電流 Peak Off State Current	I <sub>DM</sub>	Tj = 125°C, V <sub>DM</sub> = V <sub>DRM</sub>			20	mA
ピークオン電圧 Peak Off State Voltage	V <sub>TM</sub>	Tj = 25°C, I <sub>TM</sub> = 150A			1.18	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I <sub>GT</sub>	V <sub>D</sub> = 6 V, I <sub>T</sub> = 1A	Tj = -40°C		300	mA
			Tj = 25°C		150	
			Tj = 125°C		80	
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V <sub>GT</sub>	V <sub>D</sub> = 6 V, I <sub>T</sub> = 1A	Tj = -40°C		5.0	V
			Tj = 25°C		3.0	
			Tj = 125°C		2.0	
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V <sub>GD</sub>	Tj = 125°C, V <sub>D</sub> = 2/3 V <sub>DRM</sub>	0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off State Voltage	dv/dt	Tj = 125°C, V <sub>D</sub> = 2/3 V <sub>DRM</sub>	500			V/μs
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t <sub>q</sub>	Tj = 125°C, I <sub>TM</sub> = I <sub>o</sub> , V <sub>D</sub> = 2/3 V <sub>DRM</sub> dv/dt = 20V/μs, V <sub>R</sub> = 100V, - di/dt = 20A/μs		150		μs

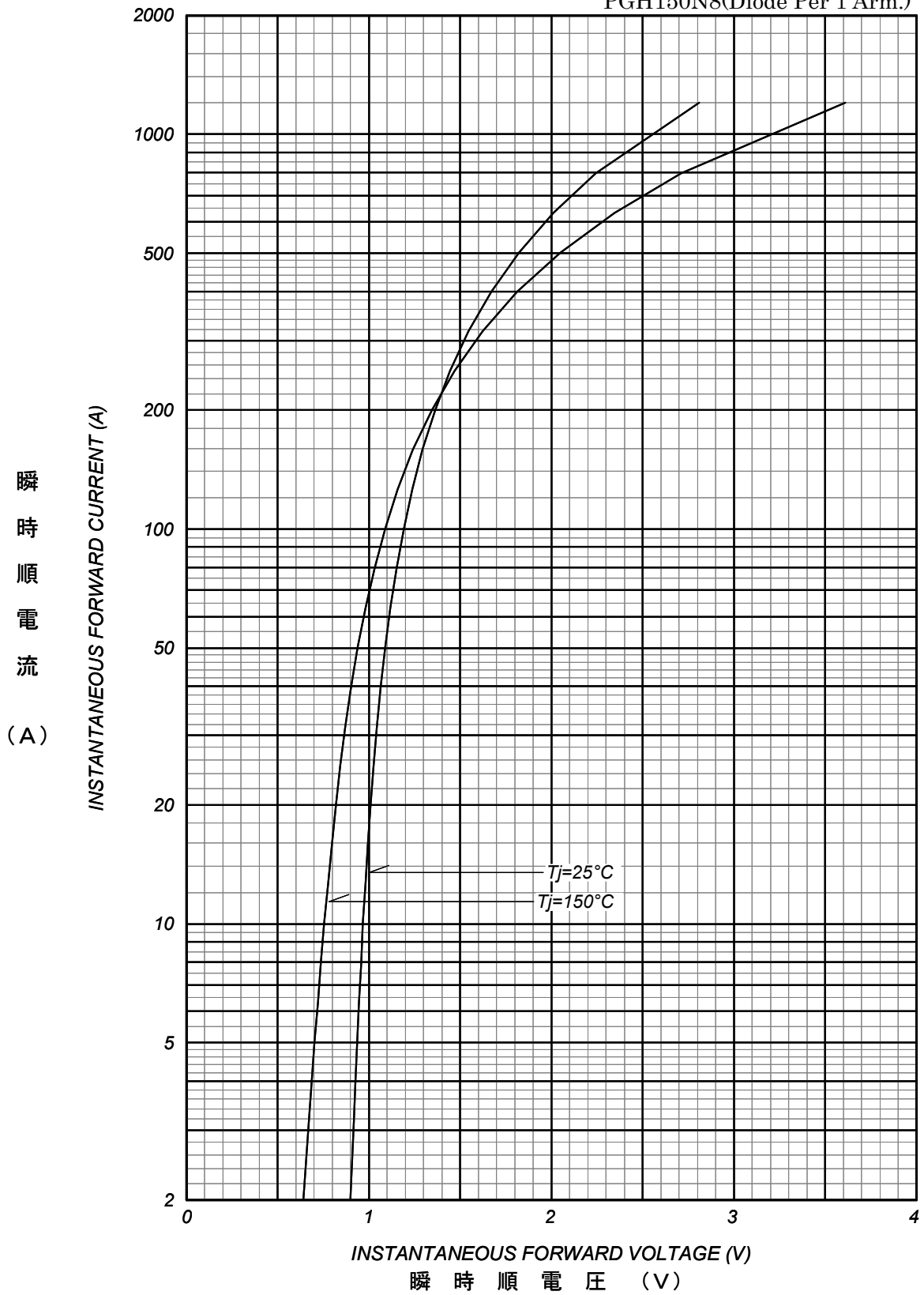
項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min	標準 Typ	最大 Max	
ターンオン時間 Turn-On Time	$t_{gt}$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$ , $V_D=2/3 V_{DRM}$ , $I_T=3 \cdot I_O$ $I_G=300\text{mA}$ , $di_G/dt=0.2\text{A}/\mu\text{s}$		6		$\mu\text{s}$
遅れ時間 Delay Time	$t_d$			2		$\mu\text{s}$
立ち上がり時間 Rise Time	$t_r$			4		$\mu\text{s}$
ラッチング電流 Latching Current	$I_L$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$		150		mA
保持電流 Holding Current	$I_H$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$		100		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部-ケース間 Junction to Case			0.23	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

質量 … 約 450g

Approximate Weight

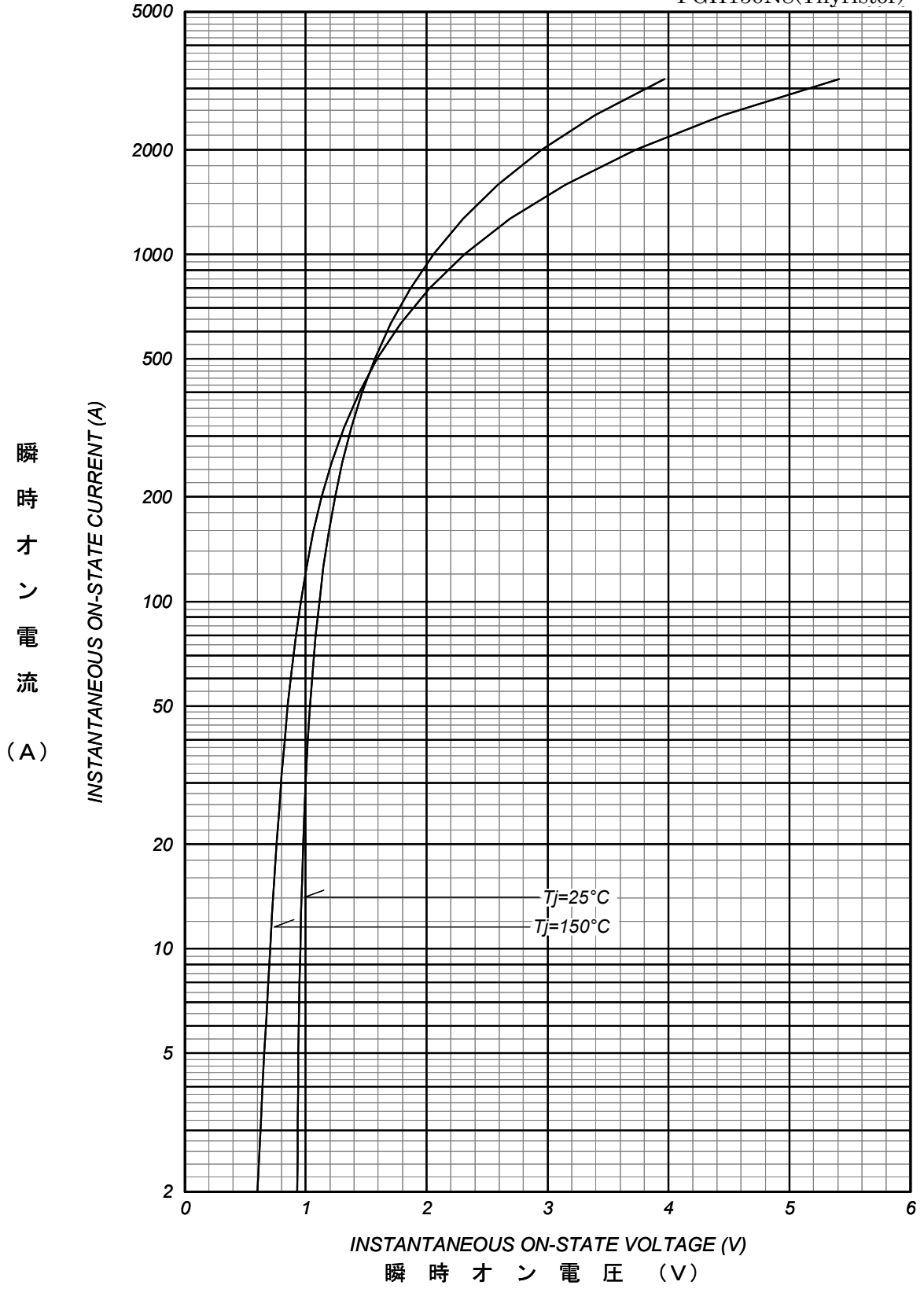
順電圧特性  
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE

PGH150N8(Diode Per 1 Arm.)

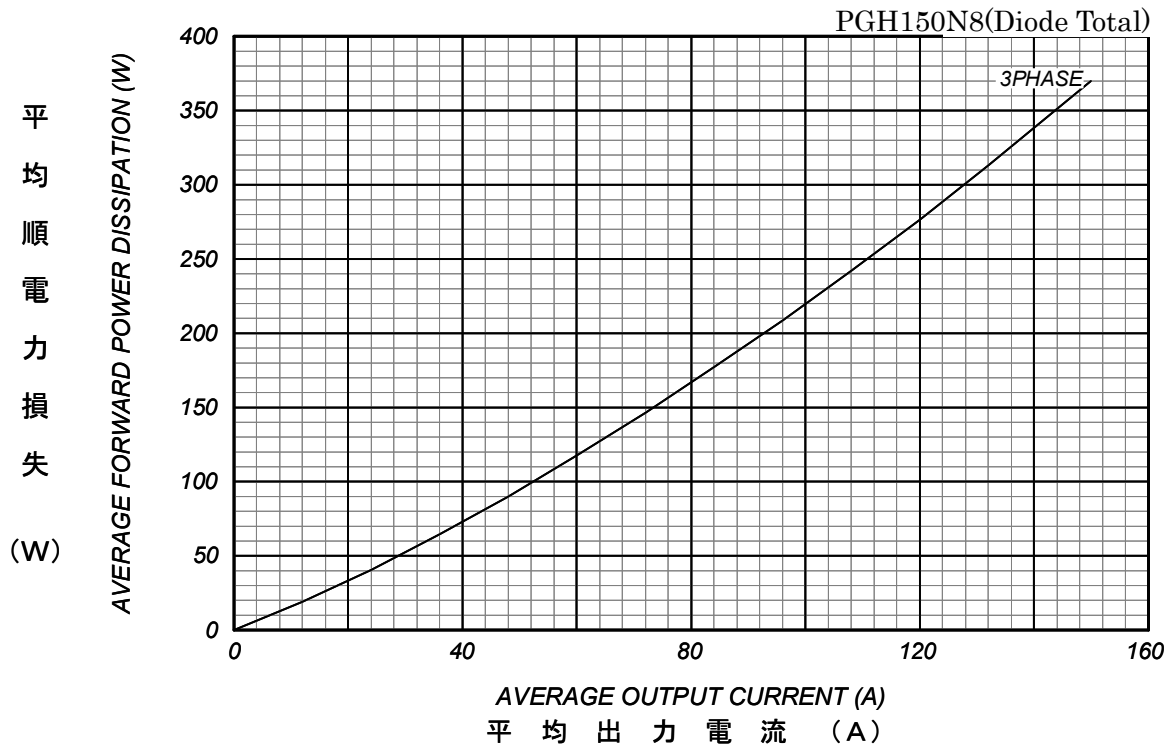


オン電圧特性  
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE

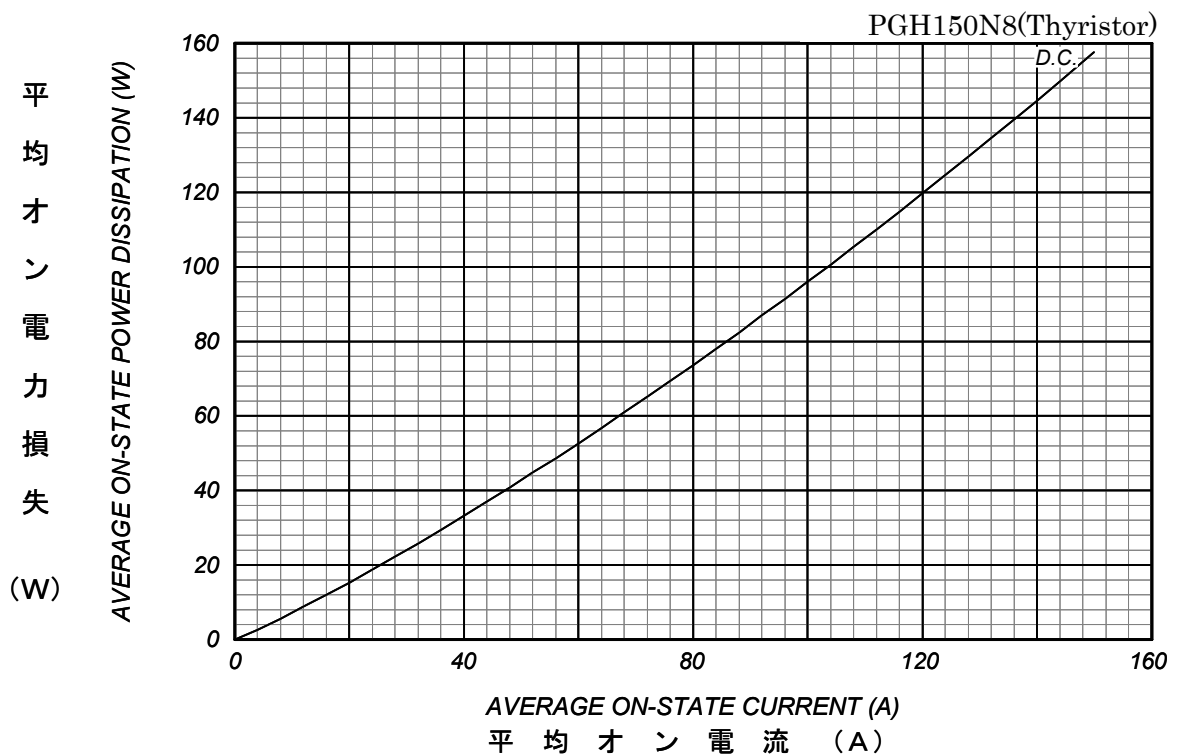
PGH150N8(Thyristor)



平均順電力損失特性  
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION

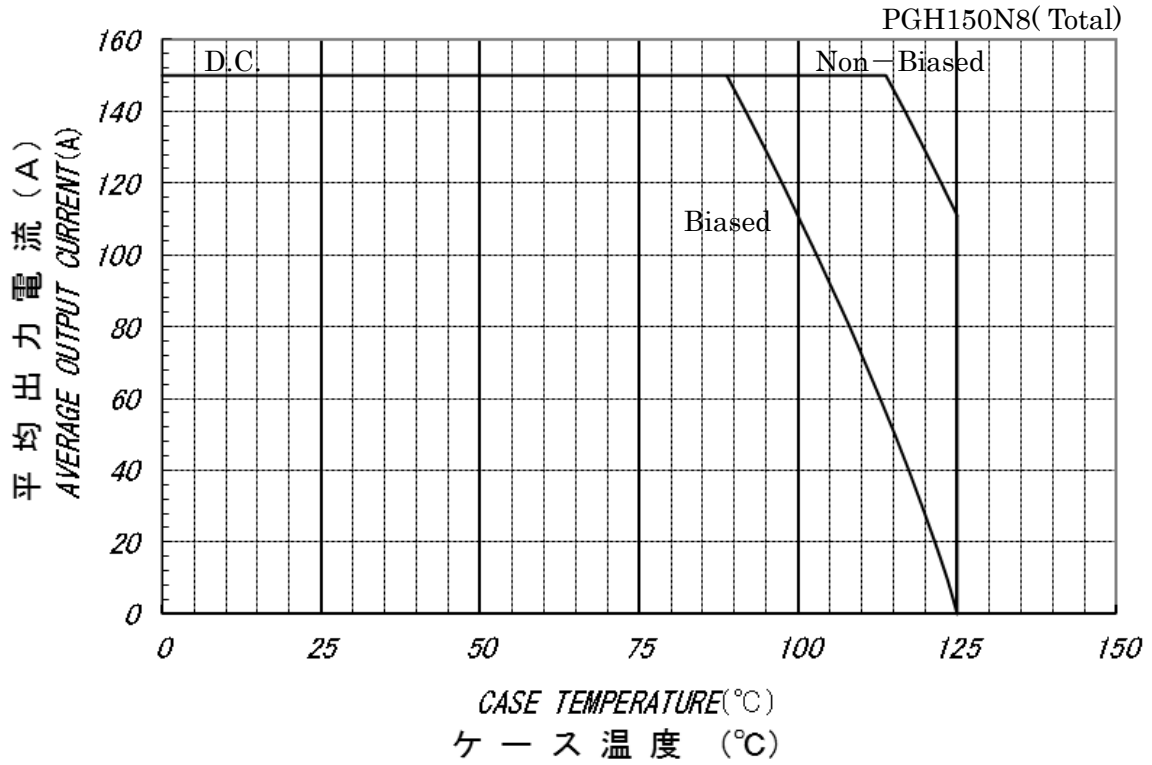


平均オン電力損失特性  
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION



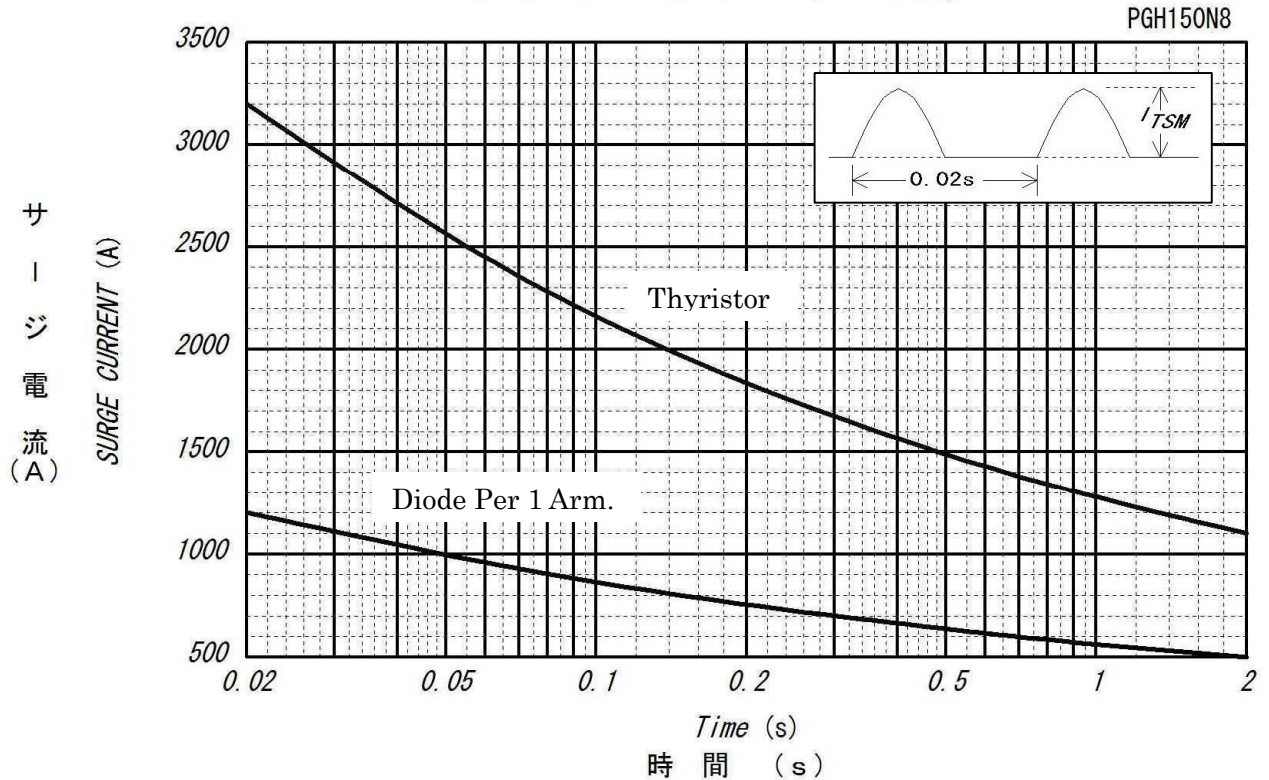
平均出力電流 - ケース温度定格  
 AVERAGE OUTPUT CURRENT VS. CASE TEMPERATURE

3-Phase Full Wave, Resistive or Inductive Load



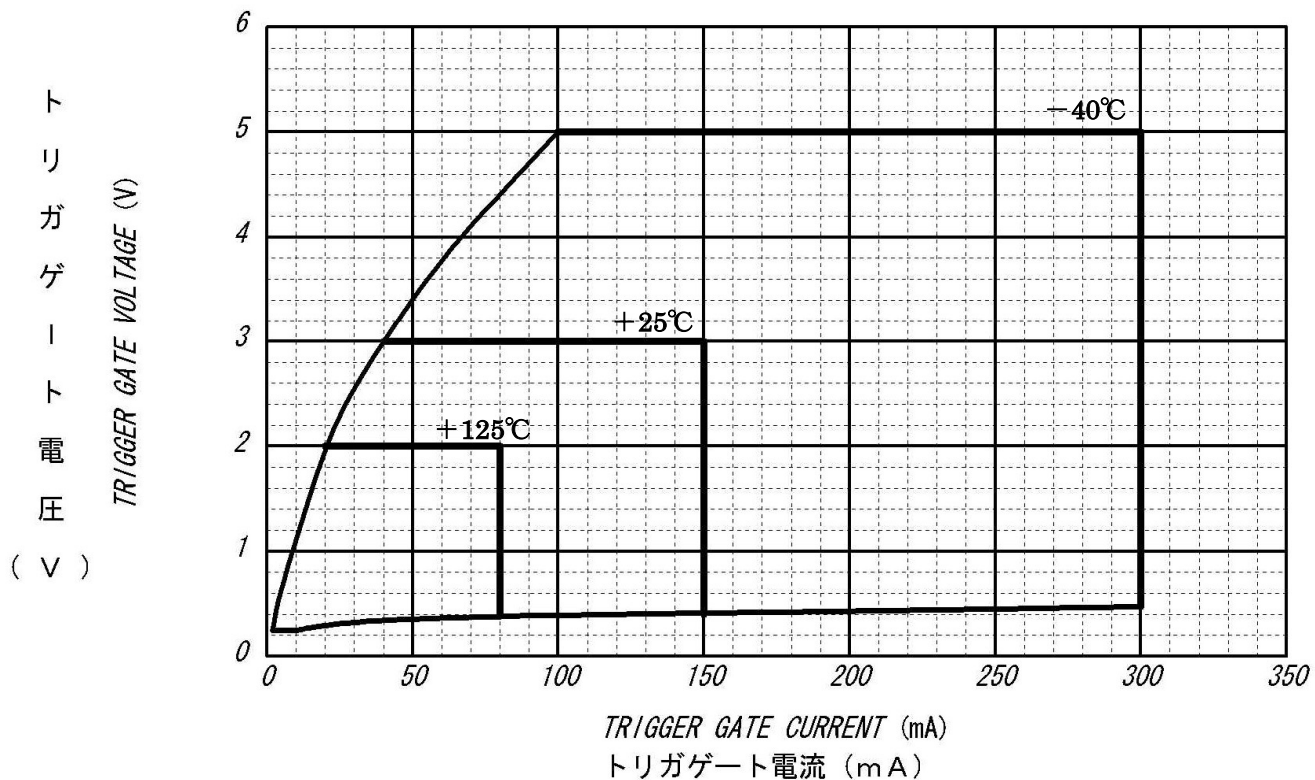
サージ電流定格  
 SURGE CURRENT RATINGS

f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, Tj=150°C

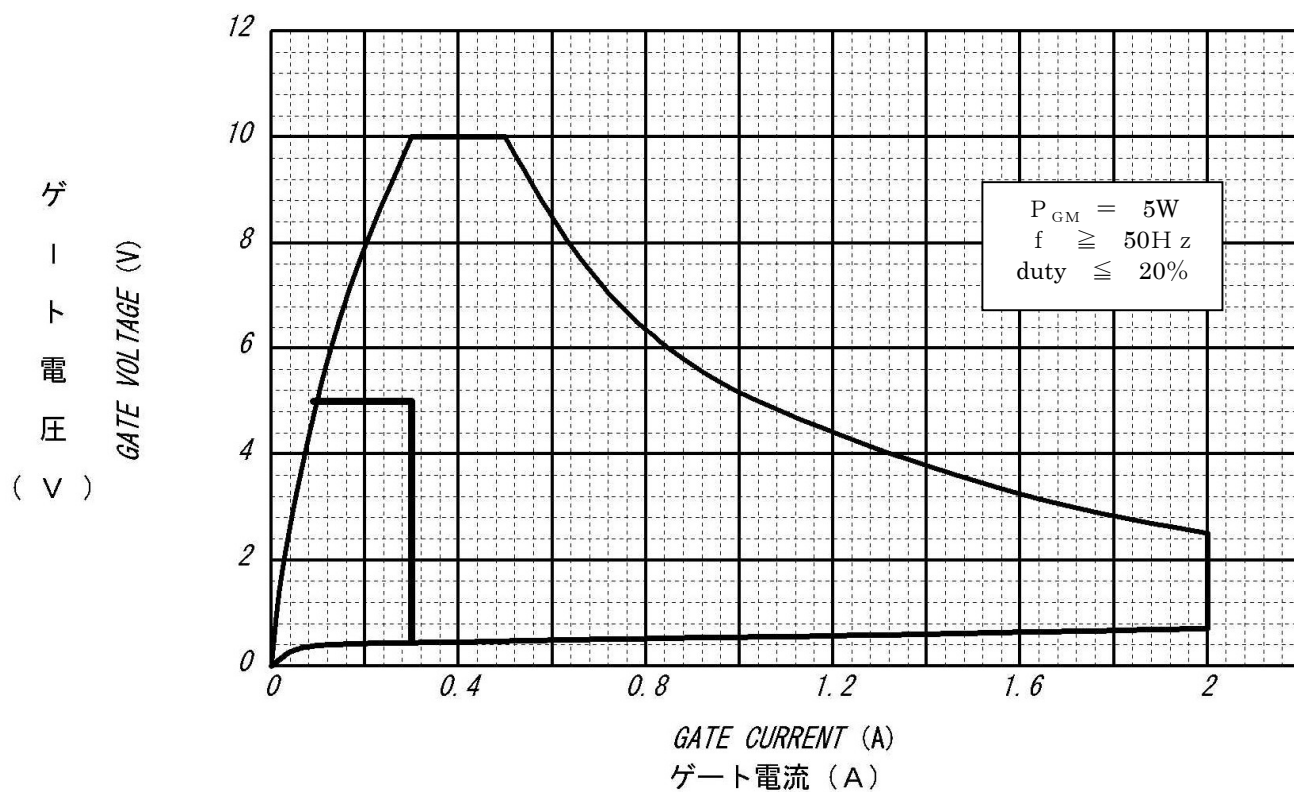




### ゲート特性 GATE CHARACTERISTICS

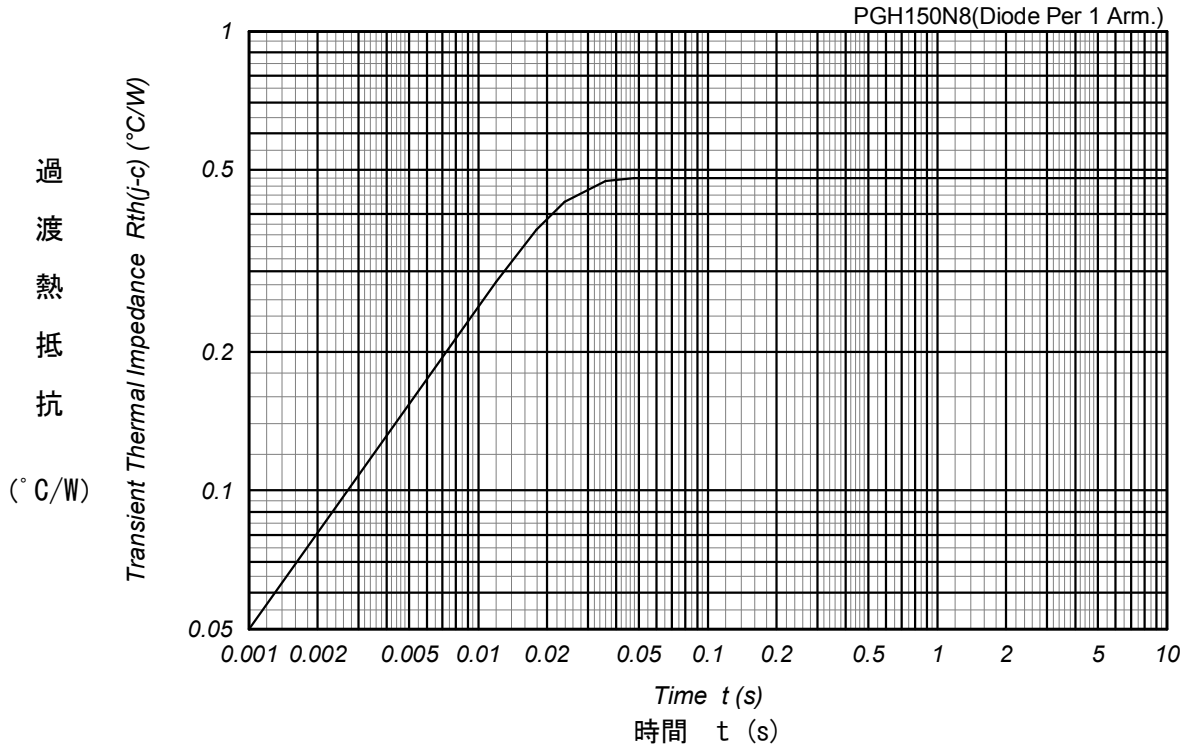


### ゲート定格 GATE RATINGS





過渡熱抵抗特性  
Transient Thermal Impedance



過渡熱抵抗特性  
Transient Thermal Impedance

